

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Дурнева Михаила Васильевича
«Спиновые расщепления валентной зоны
в полупроводниковых квантовых ямах и квантовых точках»,
представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
по специальности 01.04.10 – «физика полупроводников»

Диссертационная работа М. В. Дурнева посвящена теоретическому исследованию строения валентной зоны в полупроводниковых наноструктурах на основе кристаллов с решеткой цинковой обманки. Вопрос этот является весьма актуальным, поскольку в данных материалах валентная зона устроена довольно сложно даже в 3-хмерном случае, а наличие в низкоразмерных гетероструктурах межфазных границ приводит к дополнительному смешиванию различных дырочных состояний. В результате интерпретация, например, поведения в магнитном поле спинового расщепления экситонной линии в квантовой яме GaAs/AlGaAs (эффект Зеемана) становится совершенно нетривиальной задачей. Для анализа проблемы автором развита модель, учитывающая в общей сложности 14 электронных и дырочных энергетических зон и смешивание состояний тяжелой и легкой дырки на интерфейсах. В диссертации рассчитаны дисперсия и спин-орбитальное расщепление для нескольких верхних по энергии дырочных подзон, а также спиновое расщепление в магнитном поле для легкой дырки. Сравнение с экспериментальными данными, проведенное при учете кулоновского взаимодействия между электроном и дыркой, демонстрирует неплохое совпадение для g-фактора экситона на легкой дырке в нескольких видах квантовых ям.

Объектом другой части работы является спиновое расщепление в магнитном поле для дырок в тригональных квантовых точках на поверхности (111). На основе симметрийного анализа учтено магнитоиндукционное смешивание состояний тяжелой дырки с проекциями спина $\pm 3/2$. В результате исследована тонкая структура энергетического спектра как для нейтрального экситона, X^0 , так и для трионов, X^+ и X^- , объяснены экспериментальные спектры фотолюминесценции и построена микроскопическая модель для g-фактора легкой дырки в квантовой точке в виде правильной треугольной пирамиды.

Проведенные исследования не только позволяют объяснить качественно и количественно целый ряд экспериментальных результатов, но и дают возможность извлечь информацию о микроскопических параметрах изучаемых гетероструктур, таких как сила спин-орбитального взаимодействия, параметр интерфейсного смешивания дырочных состояний, геометрические размеры и форма наноструктур. В связи с этим рассмотренные задачи и полученные в диссертации результаты являются интересными и актуальными не только с точки зрения фундаментальной, но и прикладной физики полупроводников.

Диссертация является законченной научной работой, удовлетворяющей всем требованиям «Положения о порядке присуждения учёных степеней», а ее автор, М. В. Дурnev, заслуживает присуждения ему степени кандидата физико-математических наук.

С.н.с. ИФТТ РАН
кандидат физ.-мат. наук

А. В. Горбунов

Подпись А. В. Горбунова **ЗАВЕРЯЮ**
Ученый секретарь ИФТТ РАН
доктор физ.-мат. наук

Г. Е. Абросимова

27 мая 2014 г.

